(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2004年2月12日(12.02.2004)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2004/013590 A1

(51) 国際特許分類7: 1/04, 3/18, H01J 40/02, 43/28

G01J 1/02,

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2003/009831

(22) 国際出願日:

2003年8月1日(01.08.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2002-225262

2002年8月1日(01.08.2002) JP

- (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 浜松ホト ニクス株式会社 (HAMAMATSU PHOTONICS K.K.) [JP/JP]; 〒435-8558 静岡県 浜松市 市野町1126番地の 1 Shizuoka (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 瀧口 義浩 (TAKIGUCHI, Yoshihiro) [JP/JP]; 〒435-8558 静岡県 浜松市 市野町1126番地の1 浜松ホトニクス株式会社 内 Shizuoka (JP).

- 代理人: 長谷川 芳樹, 外(HASEGAWA, Yoshiki et al.); 〒104-0061 東京都 中央区 銀座一丁目10番6号 銀座 ファーストビル 創英国際特許法律事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

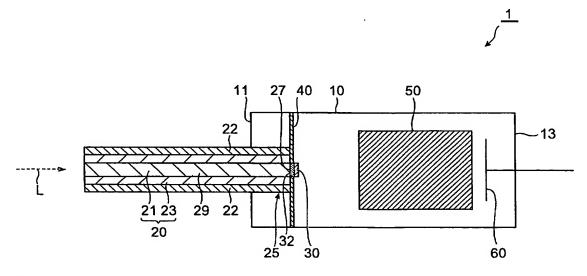
添付公開書類:

国際調査報告書

/続葉有/

(54) Title: OPTICAL SENSOR

(54) 発明の名称: 光検出装置



(57) Abstract: An optical sensor (1) comprises a photoelectric surface (30) and an electron multiplying section (50) both installed in a vacuum enclosure (10). These constitute a photoelectron multiplier tube. The optical sensor (1) has an optical fiber (20) through which an optical signal (L) travels. The photoelectric surface (30) is formed on the end surface (27) of the optical fiber (20).

(57)要約:光検出装置1は、真空容器10内に配置された光電面30及び電子増倍部50を含む。これらにより光 電子増倍管が構成される。光検出装置1は、光信号Lが流れる光ファイバ20を備え、光電面30が光ファイバ 20の端面27上に形成されている。

WO 2004/013590 A1

T TERRE ENHANCE HARVE COM ERIN ERIN ERIN ER IN DISTRICT MITTE EN EN EN EN ERIN ER E

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

明細書

光検出装置

技術分野

【0001】 本発明は、例えば、光電子増倍管のような光学部品を含む光検出 装置に関する。

背景技術

5

10

15

20

25

【0002】 図3は、従来の光検出装置の模式図である。従来の光検出装置は、光電子増倍管80及び結像系90を含む。光電子増倍管80は、管状をした真空容器81内に、真空容器81の一方の端面から他方の端面に向かって順に、電極83a、光電面85、アパーチャ電極83b、収束電極83c、電子増倍部87、読み出し電極83dが配置された構造をしている。結像系90は、互いに対向して配置されたレンズ系91、93と、レンズ系91とレンズ系93との間に配置された波長選択フィルタ95と、レンズ系93の位置を微調整する調整部97と、を含む。波長選択フィルタ95により光信号Lのうち必要となる波長成分が選択される。

【0003】 光源Sからの光信号Lは、結像系90により光電面85に結像される。調整部97を用いてレンズ系93の位置を微調整することにより、結像の調整がなされる。この結像により光電面85内の電子が励起され真空中に光電子が放出される(外部光電効果)。放出された光電子のうちアパーチャ電極83bの開口部82を通過した光電子が収束電極83cによって電子増倍部87に収束される。電子増倍部87において二次電子放出が繰り返えされることにより電流増幅される。これが出力信号として読み出し電極83dを介して読み出される。

【0004】 さて、上記光検出装置において、光電面85に入射する光信号Lの強度が極度に小さい場合、計測における信号/雑音の比は熱雑音の影響を強く受ける。つまり、熱雑音が大きくなると計測における信号/雑音の比が悪くなるのである。従って、熱雑音を低減することが重要である。熱雑音は、光電面85

の温度を低下させたりすることや、光電面85の面積を小さくすることにより、 低減することができる。従来は、ペルチェ冷却器89を光電面85の近傍に配置 することにより光電面85の温度を低下させたり、アパーチャ電極83bにより 光電面85の有効面積を低減させたりしている。アパーチャ電極83bの開口部 82の開口面積に相当する面積が光電面85の有効面積となる。

発明の開示

5

10

15

20

25

【0005】 従来の光検出装置は、アパーチャ電極83bの開口部82を通過した光電子が電子増倍部87に収束される。光電面85から放出された光電子を効率的に利用するためには、開口部82を通過する光電子を多くしなければならず、そのために、結像系90及び調整部97が必要となる。また、アパーチャ電極83bを設けることにより、光電面85とアパーチャ電極83bにより形成される電場が原因でレンズ効果が発生する。この補正のため収束電極83cが必要となる。このように、従来の光検出装置は結像系90、調整部97、収束電極83c等を備えなければならず、これらが装置の小型化の妨げとなっていた。

【0006】 本発明の目的は、熱雑音を低下させつつ、小型化が可能な光検出装置を提供することである。

【0007】 本発明に係る光検出装置は、光の出射面となる端面を有する光ファイバと、端面上に形成され端面から出射される光を基にして光電子を放出する 光電子放出部と、を含む。

【0008】 本発明によれば、光ファイバの端面上に光電子放出部(例えば光電面)が形成されているので、光電子放出部に光を結像させるための結像系や結像系のレンズを微調整する調整部が不要となる。また、同じ理由によりアパーチャ電極が不要となるので、光電子放出部とアパーチャ電極により形成される電場が原因となるレンズ効果が発生することはない。よって、本発明によればレンズ効果を補正するための収束電極を配置しなくてもよい。また、光ファイバの端面上に光電子放出部が形成されているので光電子放出部の小型化が可能となる。以

上の理由により本発明によれば、光検出装置の小型化が可能となる。

【0009】 また、上記の通り光電子放出部の小型化が可能となるので、熱雑音を低減することができる。よって、本発明によれば、計測における信号/雑音の比を良好にすることが可能となる。

【0010】 本発明において、光ファイバはコア部を含み、端面の少なくとも一部はコア部を含み、光電子放出部は端面のコア部上にのみ形成されている構造にすることが好適である。これによれば、光電子放出部をさらに小型化することができるので、熱雑音を低減することができ、計測における信号/雑音の比を良好にすることが可能となる。

【0011】 本発明において、コア部に波長選択用の回折格子が形成されている構造にすることが好適である。本発明において、光ファイバからの光漏れを防ぐために、光ファイバの表面に配置された遮光性皮膜を含む構造にすることが好適である。本発明において、光ファイバは光の入射面となる他の端面を含み、光検出装置は他の端面に取付けられた光ファイバコネクタを含む構造にすることが好適である。本発明において、光電子放出部の温度を低下させるための冷却部を含む構造にすることが好適である。

図面の簡単な説明

5

10

15

25

【0012】 図1は、本実施形態に係る光検出装置の一例の断面模式図である

20 【0013】 図2は、本実施形態に係る光検出装置の他の例の断面模式図である。

【0014】 図3は、従来の光検出装置の模式図である。

発明を実施するための最良の形態

【0015】 本発明の好適な実施形態について図面を用いて説明する。図1は、本実施形態に係る光検出装置の一例の断面模式図である。光検出装置1は、内部が真空にされたガラス管からなる真空容器10と、コア部21及びコア部21の

周囲に形成されたクラッド層23を含む光ファイバ20と、を備える。

5

10

15

20

25

【0016】 真空容器10は一方の端面11と他方の端面13を有する。光ファイバ20の端部25は、端面11から真空容器10内に挿入され、固定されている。端部25には光ファイバ20の端面27がある。コア部21を伝播した光源からの光信号Lは、端面27から出射される。端面27上のうちコア部21の部分上には、金属が吸着しやすいように表面をナノメートル程度で荒らして蒸着した下地金属層32と、光電子放出部の一例である光電面30とが積層されている。光電面30により外部光電効果が生じる。つまり、端面27から出射された光信号Lが光電面30に入射することにより、光電面30から真空容器10中に光電子が放出される。光電面30を端面27上に形成する方法として、例えば、以下の方法がある。まず、端面27上に金属層を蒸着する。この金属層をフォトリングラフィとエッチングを用いてパターニングすることにより、端面27上のうちコア部21の部分上にのみこの金属層を残す。これが下地金属層32となる。そして、下地金属層32上に光電面の材料を選択的に蒸着することにより、端面27上に光電面30が形成される。

【0017】 真空容器10内には、光電面30に下地金属層32を介して電気的に接続されている電極40が配置され、また光電面30と所定距離を設けて向かい合うように電子増倍部50が配置されている。電子増倍部50としては公知の電子増倍部が用いることができる。電子増倍部50の構造や材料は様々であり、これらにより光検出装置1の電流増倍率、時間応答特性等が異なるので、光検出装置1の使用目的に応じて、電子増倍部50の構造や材料を選択する。真空容器10内であって、端面13と電子増倍部50との間には読み出し電極60が配置されており、読み出し電極60の一部は端面13を介して外部に引出されている。真空容器10、光電面30及び電子増倍部50により光電子増倍管が構成されている。

【0018】 ここで、光検出装置1の動作を説明する。光ファイバ20のコア

部21を伝播してきた光信号Lは光ファイバ20の端面27を介して光電面30 に入射する。これにより光電面30内の電子を励起し真空中に光電子を放出する (外部光電効果)。光電子は電子増倍部50に入射する。電子増倍部50において 二次電子放出が繰り返えされることにより電流増倍された光電子は、読み出し電 極60に送られる。

5

10

15

20

25

【0019】 光検出装置1によれば、光信号Lが流れる光ファイバ20を備え、かつ光電面30が光ファイバ20の端面27上に形成されている。このため、結像系、収束電極等が不要となり、装置の小型化が可能となる。また、光伝播と光電子変換を高効率にすることが可能となる。

【0020】 また、光検出装置1によれば、光電面30が端面27のコア部2 1上にのみ形成されているので、光電面の小型化を図ることができる。よって、 熱雑音を極限まで低減することが可能となるので、計測における信号/雑音の比 を良好にすることできる。なお、光電面30は端面27のコア部21上及びクラッド層23上に形成されていてもよい。

【0021】 上記の効果について数値を用いて具体的に説明する。光検出装置 1によれば、例えば、コア部21の径が125 μ mのマルチモードファイバを用いた場合、直径5mmの光電面(通常の大きさの光電面)と比較して、光電面30は面積比で1600分の1になる。また、例えば、光電面が GaAs であり光電面の冷却部を備えた従来のタイプにおいて、光電面の雑音レベルが100cps程度となる。光検出装置1によれば、熱雑音が0.063cpsとなる。

【0022】 次に、本実施形態に係る光検出装置の他の例を説明する。図2は、この光検出装置3の断面模式図である。光検出装置3については、図1に示す光検出装置1との相違点を説明する。光検出装置3を構成する要素のうち光検出装置1の構成要素と同一のものについては同一符号を付すことにより説明を省略する。

【0023】 光ファイバ20のコア部21の一部に回折格子29が形成されて

いる。これにより、光信号のうち測定したい波長成分のみを選択することが可能となる。また、光ファイバ20の周囲には遮光用皮膜22が形成されている。これにより光ファイバ20内の光信号が外部に漏れるのを防ぐことが可能となる。光ファイバ20の端部25と反対側の端部24には、FC型の光ファイバコネクタ70が取付けられている。なお、光電面30は端面27のコア部21上にのみ形成されているが、端面27のコア部21上及びクラッド層23上に形成されていてもよい。

5

10

【0024】 真空容器10内であって端面11及び光電面30の近傍には、ペルチェ冷却器13が配置されている。ペルチェ冷却器13には貫通孔があり、そこに光ファイバ20の端部25が通されている。ペルチェ冷却器13により光電面30が冷却される。これにより、熱雑音を低減することができる。なお、光検出装置3の動作及び効果は光検出装置1と同様である。

請求の範囲

1. 光の出射面となる端面を有する光ファイバと、

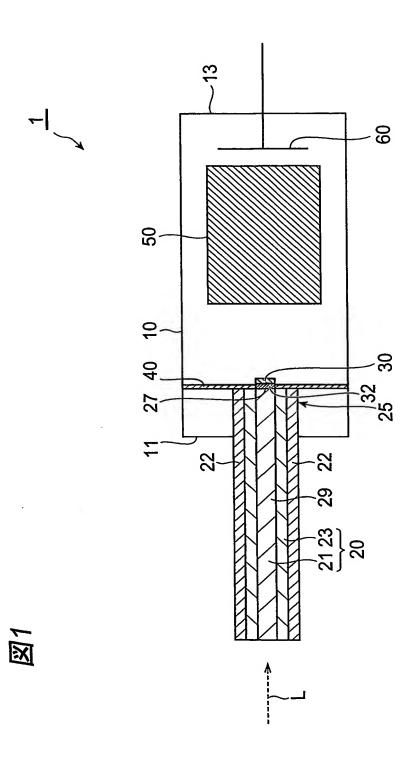
前記端面上に形成され、前記端面から出射される光を基にして光電子を放出する 光電子放出部と、

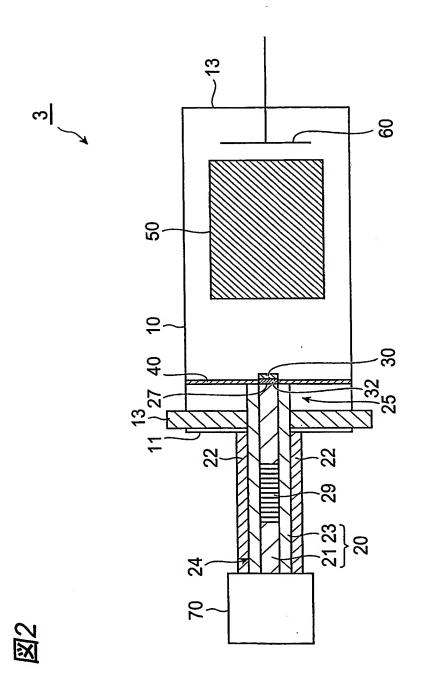
- 5 を含む光検出装置。
 - 2. 前記光ファイバはコア部を含み、

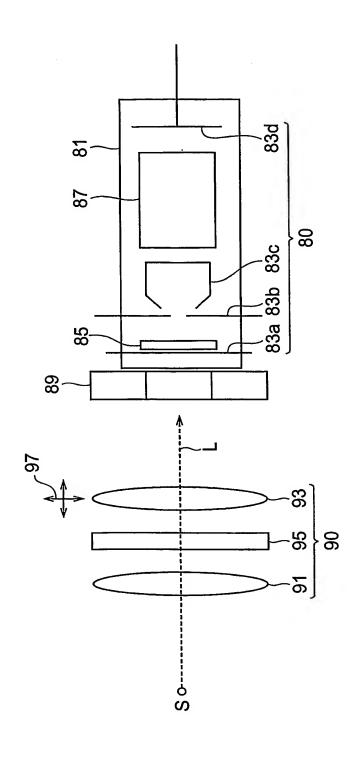
前記端面の少なくとも一部は前記コア部を含み、

前記光電子放出部は前記端面の前記コア部上にのみ形成されている、請求項1記 載の光検出装置。

- 10 3. 前記コア部に波長選択用の回折格子が形成されている、請求項1又は2 記載の光検出装置。
 - 4. 前記光ファイバからの光漏れを防ぐために、前記光ファイバの表面に配置された遮光性皮膜を含む、請求項1~3のいずれかに記載の光検出装置。
 - 5. 前記光ファイバは光の入射面となる他の端面を含み、
- 15 前記光検出装置は前記他の端面に取付けられた光ファイバコネクタを含む、請求項1~4のいずれかに記載の光検出装置。
 - 6. 前記光電子放出部の温度を低下させるための冷却部を含む、請求項1~ 5のいずれかに記載の光検出装置。
- 7. 前記端面と前記光電子放出部との間に金属層が位置する、請求項1~6 20 のいずれかに記載の光検出装置。







INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/JP03/09831

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ G01J1/02, G01J1/04, G01J3/18, H01J40/02, H01J43/28					
	2				
	o International Patent Classification (IPC) or to both nati	onal classification and IPC			
	SEARCHED				
	ocumentation searched (classification system followed by $C1^7$ $G01J1/02-1/04$, $G01J1/42$, $G01J1/42$				
1110.	G02B6/00, G02B6/42, H01J31,				
Documentat	ion searched other than minimum documentation to the	extent that such documents are included	in the fields searched		
Jitsu	iyo Shinan Koho 1922-1996	Toroku Jitsuyo Shinan Koho			
	Jitsuyo Shinan Koho 1971-2003	Jitsuyo Shinan Toroku Koho			
Electronic d	ata base consulted during the international search (name	of data base and, where practicable, sear	rch terms used)		
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category*	Citation of document, with indication, where app	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.		
	JP 61-183857 A (Hamamatsu Pho		•		
	Kaisha),				
х	16 August, 1986 (16.08.86), Full text; Figs. 1 to 6		1,4,7		
Y	Full text; Figs. 1 to 6		3,5,6		
A	Page 3, upper right column, 1		2		
	& US 4783139 A & GB	8603236 A			
Y	JP 9-61678 A (Sumitomo Electric Industries,		3,5		
	Ltd.),		•		
	07 March, 1997 (07.03.97), Full text; Figs. 1 to 17		· Ý*		
	(Family: none)		•		
	·				
× Furth	Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.				
	Opodian date Bondo of thick documents.				
consid	considered to be of particular relevance understand the principle or theory underlying the invention				
date					
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is step when the document is taken alone cited to establish the publication date of another citation or other "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be					
special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other combined with one or more other such					
means combination being obvious to a person skilled in the art "P" document published prior to the international filing date but later "&" document member of the same patent family than the priority date claimed					
Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report					
09 November, 2003 (09.11.03) 25 November, 2003 (25.11.03)					
,		Authorized officer			
Jap	anese Patent Office				
Facsimile No.		Telephone No.			



International application No. PCT/JP03/08931

ategory*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the releva	ant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 6-88747 A (Omron Corp.), 29 March, 1994 (29.03.94), Full text; Figs. 1 to 2 (Family: none)		6
A	JP 2000-90875 A (Hamamatsu Photonics Kab Kaisha), 31 March, 2000 (31.03.00), Full text; Figs. 1 to 9 (Family: none)	ushiki	1-6
A	JP 60-207083 A (Hamamatsu Photonics Kabu Kaisha), 18 October, 1985 (18.10.85), Full text; Figs. 1 to 4 (Family: none)	shiki	1-6
A	JP 48-7667 B1 (Westinghouse Electric Cor 07 March, 1973 (07.03.73), Full text; Figs. 1 to 3 (Family: none)	P.),	1-6

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP03/09831

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC)) Int. Cl' G01 J 1/02, G01 J1/04, G01 J3/18,				
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	H01J 40/02, G01J			
B. 調査を				
	最小限資料(国際特許分類 (IPC)) Cl' G01J 1/02-1/04.	G01J1/42, G01J3/		
	G01T 1/20-1/29,	G02B6/00, G02B6/4	42,	
	H01J 31/50, H01	J 40/02, H01J 43/28		
最小限資料以	外の資料で調査を行った分野に含まれるもの			
日本国第	実用新案公報1922-1996年公開実用新案公報1971-2003年登録実用新案公報1994-2003年			
日本国	登録実用新案公報 1994-2003年 1994-2003年			
日本国	実用新案登録公報 1996-2003年	· _	•	
国際調査で使	用した電子データベース(データベースの名称、	調査に使用した用語)		
C. 関連す	ると認められる文献			
引用文献の	•		関連する	
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	さきは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号	
37		Combata 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		
X	JP 61-183857 A (1986.08.16, 全文,		1, 4, 7	
Y	全文,第1-6図	第1 − 0 図	3, 5, 6	
Ā	第3頁右上欄第11-20行,第	34図	2	
	& US 4783139 A	& GB 8603236 A	_	
77	170 0 0 1 0 7 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	and the same of th		
Y	JP 9-61678 A (住友		3, 5	
	1997.03.07, 全文,第1-17図 (ファミリーなし)			
区 C欄の続きにも文献が列挙されている。				
* 引用文献		の日の後に公安された文献	•	
│「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって				
もの 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 の理解のために引用するもの				
以後に公表されたもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明				
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以				
文献 (理由を付す) 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに				
「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 よって進歩性がないと考えられるもの。 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献				
	国際調査を全てした日			
国際調査を完了した日 09.11.03 国際調査報告の発送日 25.11.03			3	
			2W 9807	
日本国特許庁 (ISA/JP) 平田 佳規 平田 佳規 90 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15				
	東京都千代田区貿が関三丁目 4番 3 号 電話番号 03-3581-1101 内線 3290			

国際調査報告					_
	-	POX.	98	コモナロ	~
	33	1	550		_

国際出願番号 PCT/JP03/09831

C(続き).	関連すると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	JP 6-88747 A (オムロン株式会社) 1994.03.29, 全文,第1-2図 (ファミリーなし)	6
A	JP 2000-90875 A (浜松ホトニクス株式会社) 2000.03.31, 全文,第1-9図 (ファミリーなし)	1-6
A	JP 60-207083 A (浜松ホトニクス株式会社) 1985.10.18, 全文,第1-4図 (ファミリーなし)	1-6
A	JP 48-7667 B1 (ウエスチングハウス・エレクトリツク・コーポレーション) 1973.03.07, 全文,第1-3図 (ファミリーなし)	1-6